

а 2004 0033

Изобретение относится к технологии полупроводниковых материалов и может быть использовано для очистки технологической оснастки от отходов после эпитаксиального выращивания слоев арсенида галлия или фосфида индия.

Способ очистки технологической оснастки от отходов после эпитаксиального выращивания слоев типа A^3B^5 включает химическую обработку путем погружения части технологической оснастки с отходами в емкость, заполненную кислотным раствором, содержащим смесь азотной кислоты HNO_3 и хлористоводородной кислоты HCl , последующую ее промывку деионизованной водой и сушку. Химическую обработку проводят кислотным раствором, который содержит 25...52%об. азотной кислоты HNO_3 . Кислотный раствор предварительно дегазирован в течение 1,5...4 часов в деионизованной воде.

П. формулы: 2

Фиг.: 2